سنتز بورنیت (Cu5FeS4) نانوساختار با روش آلیاژسازی مکانیکی و بررسی اثر دوپ کردن هم زمان Zn و Co بر روی خواص ترموالکتریکی آن

احمد استواری مقدم^{۱،} علی شکوه فر ۱- دانشجوی دکتری، مهندسی مواد، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران ۲- استاد، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران *مسئول مکاتبات: aostovari@mail.kntu.ac.ir (تاریخ دریافت: ۱۳۹۷/۰۶/۲۹، تاریخ پذیرش:۱۳۹۷/۰۹/۱۳

چکیده: برای توسعه دستگاههای حالت جامد ترموالکتریک، موادی با بازده بالا که از عناصر غیر سمی و فراوان در پوسته زمین تشکیل شده باشد از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این مقاله، خواص ترموالکتریک نمونههای نانوساختار ($0.0 \ge x \ge 0.3$, $Co_x FeS_4$ ($0.05 \ge x \ge 0.06$) مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور، ابتدا نانوذرات $Cu_{5.2x}Zn_xCo_xFeS_4$ توسط آسیاب گلولهای پرانرژی سنتز شد و سپس نمونههای نانوساختار دیسکی شکل با پرس داغ تهیه شد. روش پراش اشعه ایکس (XRD) برای مطالعه خواص ساختاری، میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) برای مطالعه خواص ساختاری، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) برای بررسی ریزساختار نمونههای نانوساختار دیسکی شکل با پرس داغ تهیه شد. روش پراش اشعه ایکس (XRD) برای مطالعه خواص ساختاری، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) برای حرارتی بررسی ریز ساختار نمونهها مورد استفاده قرار گرفت و خواص ترموالکتریک نمونهها نیز با اندازه گیری رسانایی الکتریکی و هدایت (TEM) برای بررسی ریز ساختار نمونهها مورد استفاده قرار گرفت و خواص ترموالکتریک نمونهها نیز با اندازه گیری رسانایی الکتریکی و هدایت حرارتی بررسی شد. نتایج XRD مورد استفاده قرار گرفت و خواص ترموالکتریک نمونهها نیز با اندازه گیری رسانایی الکتریکی و هدایت حرارتی بررسی شد. نتایج XRD مورد استفاده قرار گرفت و و وی ترمونه های 4^{-1} ساختار بود و پس از دوپ کردن با 20 و Zn روبیت خالص است. ضریب توان نمونه های بورنیت دوپ نشده برابر با -18^{-1} ساختار بود و پس از دوپ کردن با 20 و Zn روبینی خالص است. خوب توان نمونه های بود نیسان ایران -18^{-1} برای تای و میزینت خالص است. خالی نوسانات جرمی و کرنتی ناشی از دوپ کردن و نانوساختار بودن، هدایت حرارتی بسیار اندک کره کاهش یافت. به دلیل نوسانات جرمی و کرنشی ناشی از دوپ کردن و نانوساختار بودن، هدایت حرارتی بسیار اندک کره می ایرای تمام نمونه های دوپ شده بدست آمد. بیشترین مقدار -18^{-1} برای نمونه دوپ شده با مقدار -18^{-1} برای تمام نمونه وی شده با مقدار -18^{-1} برای تمام نمونه دوپ شده با مقدار -18^{-1} برای تمام نمونه دوپ شده با مقدار -18^{-1} با معاد دوپ شده با مقدار -18^{-1} با معاد دوپ شده با مقدار -18^{-1} با معاد دوپ شده با مقدار -18^{-1} با می دوپ شده ب

واژههای کلیدی: بورنیت، نانوساختار، دوپ کردن، آلیاژ سازی مکانیکی، خواص ترموالکتریک.

۱- مقدمه

بستگی دارد. معیار شایستگی با رابطه T(S²/ρλ_T) تعریف می شود که ۵، β، T و λ_r به ترتیب ضریب سیبک^۲، مقاومت الکتریکی، دمای مطلق و هدایت حرارتی کل است [۳–۱]. در حال حاضر ژنراتورهای ترموالکتریک پتانسیل استفاده در گستره وسیعی از کاربردها از تولید برق در اگزوز خودروها گرفته تا تولید برق در کاوشگرهای فضایی را دارد. با این وجود، در حال حاضر به دلیل قیمت بالا و بازدهی کم، کاربرد این مولدها به در اثر مصرف بسیار زیاد منابع تجدیدناپذیر (سوختهای فسیلی)، برای اولین بار در تاریخ حیات زمین بحث بحران جهانی انرژی با جدیت زیادی مطرح شده است. در سالهای اخیر، مواد ترموالکتریک (TE) به دلیل قابلیت تبدیل مستقیم حرارت به برق، توجهات زیادی را به خود به عنوان منابع انرژی جایگزین جلب کرده است. بازده تبدیل انرژی این مواد که خاصیت ذاتی هر ماده ترموالکتریک است، به معیار شایستگی^۱ ماده ترموالکتریک

توليد مي شوند، كه به دليل سمي بودن عناصر آنها و همچنين کمیابی Te امکان تولید انبوه مولدهای تر موالکتریک ممکن نشده است [۸-۷]. با این وجود، در سال های اخیر تحقیقات بسیار زیادی در راستای کشف مواد ترموالکتریک جدید با بازده بالا و هزینه توليد كم انجام شده است. به عنوان مثال، مواد ترموالكتريك سولفیدی گروهی جدید از مواد ترموالکتریک هستند که در سال های اخیر معرفی شدهاند [۵، ۹]. تحقیقات انجام شده بر روی این ترکیبات سولفیدی بسیار نوید بخش بوده است. در واقع، این ترکیبات گروه جدیدی از مواد ترموالکتریک هستند که از مواد غیر سمی مانند مس و گو گرد تشکیل شده است. از جمله تر کیبات سولفیدی نظیر تتراهدریت (Cu12Sb4S13) [۱۰]، بورنیت (Cu₅FeS₄) [11] و Cu_{1-x}S [11] اساسا به دلیل هدایت حرارتی شبکه پایین، توجهات زیادی را به خود جلب کرده است. بورنیت دارای یک فاز مکعبی دما بالا (بورنیت بالا) در دماهای بالاتر از 473 ، یک فاز مکعبی میانی (بورنیت میانی) در دمای بین 473 K K تا K 543 و يک فاز اورتورومبيک دما يايين (بورنيت يايين) در دماهای کمتر K 473 است [۱۳]. سه ساختار بلوری بورنیت در شکل (۱) نشان داده شده است. بورنیت از عناصر غیر سمی و فراوان در پوسته زمین تشکیل شده است و می تواند یک گزینه مناسب برای کاربردهای ترموالکتریک باشد. با این وجود، خواص ترموالكتريك اين ماده تاكنون زياد مورد توجه قرار نگرفته است. به ویژه، تا کنون فقط اثر دوپ کردن بورنیت با Mn [۱۴] و Se [۱۵] بررسی شده است. در پژوهش های قبلی ما، اثر دوپ کردن با Coنیز بررسی شد [۱۶].

با عنایت به مطالب مطرح شده، در این کار تحقیقاتی، ابتدا نانوذرات بورنیت با روش آلیاژسازی مکانیکی سنتز شد و سپس اثر جایگزین کردن هم زمان Co و Zn به جای Cu در ساختار بورنیت بر روی خواص ترموالکتریک آن مورد بررسی قرار گرفت.

صنايع استراتژيک محدود شده است. اثر ترموالکتريک مي تواند انرژي حرارتي را بهطور مستقيم به انرژي الکتريکي تبديل کند و لذا به عنوان یک روش جایگزین برای تولید برق مطرح بوده است. این موضوع باعث شده است که در طول بیش از یک قرن مواد ترموالکتریک توجهات بسیار زیادی را به خود جلب کند. مواد تر موالکتریک مناسب نیمه هادی هایی با شکاف باند باریک است. همچنین، به منظور حفظ رسانایی الکتریکی، تحرک حامل ها باید زياد بماند، درحالي كه هدايت حرارتي شبكه بايد كمينه شود. به طور کلی، بر اساس نظریه انتقال دو روش اصلی برای بهبود ZT مواد TE وجود دارد. یک رویکرد افزایش ضریب توان^۳ (PF=S²/ρ) و رویکرد دیگر کاهش هدایت حرارتی شبکه است [۴]. روش معمول بیشینه کردن مقدار PF، تنظیم غلظت حامل ها در گستر می بهینه (از مرتبه ۱۰^{-۲۰} cm⁻³ تا ۱۰^{-۱۹}) است [۵]. با این وجود، کاربرد این روش با دو واقعیت محدود شده است: بیشینه ضریب توان توسط طبیعت خود مواد تعیین میشود، و ضریب سيبك و رسانايي الكتريكي معمولاً با رابطه پيسارنكو ً به هم مرتبط میشوند، که بهبود یک پارامتر بدون فدا کردن پارامتر دیگر بسیار چالش برانگیز است. در واقع، بسیار کاربردیتر و آسان تر است که معیار شایستگی را با کاهش هدایت حرارتی شبکه، که تا حد زیادی مستقل از خواص الکتریکی است بهبود داد [۵]. هدایت حرارتی کل k، دارای دو سهم انتقال فنون و الکترون است و بنابراین می تواند به دو بخش هدایت حرارتی الكترونيكي و هدايت حرارتي شبكه تقسيم شود (k = k + k). مفهوم فنون آمورف/الكترون كريستال براى توصيف موادى توسعه یافت که هدایت حرارتی شبکه آنها همانند مواد آمورف و خواص الکترونیکی آنها به خوبی مواد کریستالی است. برای مواد آمورف، مسير آزاد متوسط فنونها در محدوده فواصل اتمي است، و بنابراین این مواد دارای کمترین مقدار هدایت حرارتی هستند. اما، هدایت الکتریکی بسیار اندک این مواد مانع از افزایش ZT می شود، مواد مناسب برای ترموالکتریک، مواد کریستالی با حداقل هدایت حرارتی ناشی از پراکندگی ذاتی فنون ها است [۶]. در حال حاضر مواد ترموالكتريك صنعتى بر پايه BiTe و PbTe



۲- مواد و روش انجام تحقیق ۱-۲- سنتز نانوذرات Cu_{5-2x}Zn_xCo_xFeS4

برای این منظور، از روش آلیاژسازی مکانیکی استفاده شد. بدین صورت که، پودرهای مس، روی، آهن، کبالت و گوگرد با خلوص بالاتر از ۹۹/۵٪ با نسبت استوکیومتری وزن شد و درون یک محفظه ۷۰ میلیلیتری از جنس فولاد ابزار SPK قرار گرفت. فرآیند آلیاژسازی مکانیکی توسط یک آسیاب گلولهای پرانرژی با سرعت چرخش ۲pm ۱۰۰۰ و نسبت گلوله به پودر ۱۰ به ۱ به مدت ۳ ساعت انجام شد. اندازه گلولهها بین ۶ تا ۱۰ میلیمتر بود. بعد از هر ۱۰ دقیقه آسیاب کاری، دستگاه به مدت ۲۰ دقیقه متوقف شد تا از افزایش دما درون محفظه و آسیب دیدن آسیاب جلوگیری شود. حدود ۲٪ وزنی اسید استئاریک به عنوان عامل جلوگیری کند. پس از آسیاب کاری، به منظور حذف اسید استئاریک و افزایش بلورینگی، پودرها در دمای K ۵۳ به مدت ۱ ساعت در اتمسفر آرگون آنیل شد.

۲-۲- فرآیند پرس داغ برای این منظور، یک دستگاه پرس مخصوص که درون یک گلاوباکس قرار داشت مورد استفاده قرار گرفت. تمام فرآیند

حرارت دادن و سرد شدن پودرها تحت اتمسفر آرگون انجام شد تا از هر گونه اکسید شدن پودرها جلوگیری شود. پودرها درون یک قالب گرفیتی قرار داده و به شکل دیسکهایی با قطر ۱۰ میلیمتر و ضخامت ۱/۳ میلیمتر پرس شدند. فرآیند پرس در فشار میلیمتر و دمای ۶۷۳K به مدت ۵ دقیقه انجام شد. چگالی تمام نمونهها (با روش ارشمیدس محاسبه شد) بیشتر از ۸۸٪ چگالی تئوری بورنیت بود.

۳-۲- روشهای تعیین مشخصات مواد ترموالکتریک تهیه شده

ساختار كريستالي و اندازه متوسط كريستاليت Cu_{5-2x}Zn_xCo_xFeS₄ توسط روش پراش اشعه ایکس با دستگاه مدل بروكر AXS D8 با استفاده از تابش Cu Ka (۵۴/۱ = ۱/۹۵) انجام شد. الگوهای پراش در دامنه 20 از ۲۰ تا ۸۰ درجه با نرخ اسکن 5/۰۲ ۰/۰۰ مشخصه یابی شدند. مورفولوژی نمونه ها توسط آنالیز میکروسکوپ الکترونی عبوری بر روی دستگاه زایس لیبرا ۱۲۰ در ولتاژ کاری ۱۲۰ kV و میکروسکوپ الکترونی روبشی (دستگاه زایس اوریگا) در بزرگنماییهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت و نتایج آن گزارش شد. از طیف سنجی پراش انرژی پرتو ایکس برای تعیین عناصر موجود در هر ساختار استفاده شد. مقاومت الکتریکی و ضریب سیبک به طور هم زمان توسط دستگاه لینسس LSR-3 در اتمسفر هلیوم از دمای محیط تا ۵۹۰ K اندازه گیری شد. نفوذپذیری حرارتی از دمای محیط تا ۵۹۰ K توسط دستگاه فلش زنون XFA 600 تحت خلا اندازه گیری شد. چگالی نمونه ها توسط روش ارشمیدس محاسبه شد و گرمای ویژه نيز از تقريب دلونگ-پتيت (CP = 0.497 J K⁻¹ g⁻¹) بدست آمد. هدایت حرارتی (λ) نمونه ها از حاصلضرب نفوذپذیری حرارتی (α)، چگالی (ρ) و ظرفیت گرمایی (*Cp*) بدست آمد $(\lambda = \alpha \times \rho \times Cp)$

> ۳- نتایج و بحث ۱-۳- مشخصه یابی ساختاری

شکل (۲) الگوهای پراش اشعه ایکس برای نمونههای Cu_{5-2x}Zn_xCo_xFeS₄ را در حالت آسیاب کاری شده و بعد از پرس داغ نشان میدهد.



شکل (۲): نتایج طیف سنجی پراش ایکس نمونه Cu_{5-2x}Zn_xCo_xFeS4 در حالت: (الف): آسیاب کاری شده و (ب): پرس شده

الگوی پراش بورنیت پایین نیز به صورت خطوط عمودی شکل نشان داده شده است. پس از آسیاب کاری پودرها دارای ساختار بورنیت مکعبی دما بالا هستند (شماره کارت ۰۰۲-۱۳۰۴)، و پس از آنیل و پرس، طیف حاصل از نمونههای دیسکی شکل منطبق با بورنیت اور تورومبیک (کارت شماره ۰۴۲-۰۵۸۶) است. تفاوت

بین ساختارهای بورنیت در واقع میزان نظم بلند دامنه آنها است. فاز مکعبی دما بالا دارای کمترین نظم ساختاری است، در حالی که فاز اورتورومبیک دما پایین بیشترین نظم را دارد [۱۷]. در تمام ساختارهای بورنیت اتمهای گوگرد مکانهای اصلی شبکه را اشغال مي كنند. در بورنيت بالا، پنج اتم مس و يك اتم آهن همراه با دو تهیجای به صورت تصادفی در هشت فضای بین نشینی تتراهدرال پخش میشوند [۱۸]. بورنیت میانی از تناوب دو زیرشبکه M1 و M2 در سه جهت کریستالو گرافی تشکیل شده است که منجر به تشکیل یک ابر شبکه a)2a یارامتر شبکه بورتیت بالاست) از بورنیت بالا می شود [۱۹]. زیر شبکه M1 دربردارنده تهی جای است و شامل توزیع نامنظم ۴ اتم مس و ۴ تهی جای در فضای بین نشینی تتراهدرال است، در حالی که زیر شبکه M2 عاری از تهی جای است و تمام هشت فضای تتراهدرال آن به صور تصادفی بین اتمهای مس و آهن پخش میشود [۲۰]. استحاله بورنیت میانی به بورنیت پایین (اورتورومبیک) از طریق آرایش ۴ تهى جاي زير شبكه هاي M1 درون يك مختصات تتراهدرال شبيه به ساختار ZnSانجام می شود [۲۱]. جهت گیری این آرایش منظم تهیجایها در طول محور b به صورت تناوبی تغییر میکند که منجر به یک ابرشبکه 2a4a2a در طول محور b می شود [۲۰]. بنابراین، به دلیل طبیعت آلیاژسازی مکانیکی و اعمال کرنش زیاد به نمونهها، فاز بورنیت بالا که ساختار نامنظم و انرژی تشکیل کمتری دارد ایجاد میشود. از آنجایی که این فاز در دمای پایین پایدار نیست، بعد از آنیل و پرس، استحاله منظم-نامنظم در بورنیت رخ میدهد و ساختار اورتورومبیک دما پایین پایدار میشود. پیکهای این دو ساختار با توجه به شباهت ساختاری، همان طور که در شکل (۲) نیز ملاحظه می شود بسیار به هم نزدیک است. قويترين ييک بورنيت بالا و يايين به ترتيب در 47.046=20 و 46.93=20 اتفاق میافتد. پودرهای دوپ شده نیز مشابه با نمونه های دوپ نشده در حالت آسیاب شده و پرس شده به ترتیب دارای ساختار بورنیت بالا و پایین است. هیچ اثری از ناخالصي،هايي مانند كالكوپيريت (CuFeS₂)، پيريت (FeS₂) يا پیرهوتیت (Fe_{1-x}S) در ساختار نمونه های دوپ شده دیده

۲-۳- بررسی ریزساختاری نمونهها

با توجه به طبیعت فرآیند آسیاب کاری، یک مورفولوژی تقریبا کروی نامنظم برای تمام پودرها بدست آمد. تصویر TEM نانو پودرهای ۲۹.2xZn_xCo_xFeS برای 0.02 = x و 0.06 = x در شکل (۳) نشان داده شده است.



شکل (۳): تصویر TEM نانو پودرهای Cu5_{-2x}Zn_xCo_xFeS₄ بعد از ۳ ساعت آسیاب کاری برای: (الف): 0.06 = x و (ب) 0.02

مشاهده مي شود كه ذرات تقريبا كروى شكل با اندازهاي در حدود ۵ تا ۴۰ نانومتر بعد از ۳ ساعت آسیاب کاری بدست آمده است. علاوهبر این، مشاهده می شود که دوپ کردن تاثیر چندانی بر روی ریزساختار نمونهها ندارد. لذا، تصاویر TEM دیگر نمونهها در اینجا نشان داده نشده است. شکل (۴) تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از سطح شکست نمونه های پرس شده را نشان مىدهد. نانوذرات به هم چسبيده با فصل مشترك واضح مشخصه مورفولوژیکی تمام نمونههای دوپ شده و دوپ نشده است. اندازه این نانوذرات برای تمام نمونه ها در محدوده ۳۰ تا ۵۰ نانومتر است که اندکی بزرگتر از اندازه ذرات نانو پودرها (شکل ۳) است. به نظر میرسد آنیل و پرس داغ منجر به رشد اندک نانوذرات شده است. با این وجود، با توجه به اندازه دانهی نمونههای پرس شده، می توان نتیجه گرفت که تنها رشد اندکی در حین آنیل و پرس داغ رخ داده است و طبیعت نانوساختار نمونهها به خوبی حفظ شده است. حفظ ساختار نانو در حین آنیل و پرس داغ یک مشخصه کلیدی برای کاهش هدایت حرارتی و لذا بهبود خواص ترموالکتریک نمونه ها است. گزارش شده است که مشخصات ریزساختاری با اندازهای کمتر از ۱ میکرون میتواند انتشار فنونهای فرکانس بالا را مختل و لذا هدایت حرارتی شبکه را كاهش دهد [۲۲]. بنابراین، می توان انتظار داشت كه نانوساختارهای بدست آمده باعث کاهش بیشتر هدایت حرارتی بورنیت و لذا بهبود ZT شود. آنالیز عنصری بر روی نمونههای پرس شده انجام و نتایج در جدول (۱) نشان داده شده است. ترکیب شیمیایی نمونهها از نتایج EDX تعیین شد و ملاحظه میشود که تطابق خوبی با ترکیب شیمیایی اسمی دارد. وجود کبالت و روی نیز در تمام نمونههای دوپ شده اثبات شد. در ترکیب شیمیایی تمام نمونهها انحراف از ترکیب استوکیومتری به صورت غنی بودن گوگرد و آهن و کمبود مس مشاهده می شود. ترکیب شیمیایی کلی نمونهها نشان میدهد که تلفات عناصر در حين سنتز و يرس نمونه ها حداقل بوده است.



آمدہ از نتایج EDX	شیمیایی بدست	جدول (۱): ترکیب
-------------------	--------------	-----------------

Cu _{5-2x} Zn _x Co _x FeS ₄		
Х	EDS composition	
0	$Cu_{4.90}Fe_{1.02}S_{4.08}$	
0.02	$Cu_{4.87}Zn_{0.02}Co_{0.018}Fe_{1.04}S_{4.05}$	
0.04	$Cu_{4.8}Zn_{0.037}Co_{0.041}Fe_{1.03}S_{4.05}$	
0.06	$Cu_{4.80}Zn_{0.058}Co_{0.061}Fe_{1.04}S_{4.04}$	

۳-۳- خواص ترموالکتریکی ۱-۳-۳- خواص انتقالی

خواص انتقالی نمونه CusFeS4 به عنوان تابعی از دما در شکل ۵ نشان داده شده است. شکل (۵-الف) وابستگی مقاومت الکتریکی به دما را نشان میدهد. مقاومت الکتریکی CusFeS4 در دمای محیط ν/۱۱۴۴ mΩm است و به طور پیوسته تا دمای ۵۹۰ درجه کلوین به ۵۹۳ ۰/۰۷۴۵ کاهش مییابد. این مقادیر نزدیک به مقاومت حرارتی گزارش شده برای این ماده توسط گویلمئو [10] و زانگ [۲۳] است.







شکل (۶): (الف): مقاومت الکتریکی، (ب): ضرایب سیبک و (ج): ضریب شکل (۶): (الف): مقاومت الکتریکی، (ب): ضرایب محدودہ $x \leq x \leq 0.02$ توان، برای نمونہ های 0.04

همان طور که در شکل (۷) مشاهده می شود برای مقادیر بالاتر جایگزینی (x = 0.06)، ضرایب سیبک دوباره رفتار هدایت نوعpاز خود نشان می دهد (شکل ۷ ⊣لف). هیچ توضیح روشنی برای منشا این انتقال هدایت از نوع-n به نوع-p وجود ندارد. با این وجود، در سطح جایگزینی x = 0.06 ییکهای مربوط به فاز لینیت ضریب سیبک بورنیت نیز یک رفتار نوع-pاز خود نشان میدهد. یک تغییر غیر معمول در رفتار سیبک در دمای نزدیک K۴۰ K مشاهده می شود که متناظر با تغییر استحاله بورنیت اورتورومبیک پایین به بورنیت مکعبی میانی است [۲۴]. بیشترین ضریب سیبک در دمای A۹۰ K برابر با ۲۳/μ ۱۳۶ بدست آمد. بیشترین مقدار ضریب توان نیز برابر با ۲۰-۲۵ mWm بدست آمد.

شکل (۴) خواص انتقالی نمونههای Cu_{5-2x}Zn_xCo_xFeS4 برای x = 0.02 و x = 0.04 را نشان می دهد. مشاهده می شود مقاومت x = 0.02الکتریکی نمونههای دوپ شده با کبالت و روی تا حد بسیار زیادی افزایش مییابد (شکل ۶–الف). علاوه بر این، نمونههای دوپ شده بر خلاف نمونه دوپ نشده هدایت نوع-n نشان میدهد. این رفتار نیمههادی نوع-n از دمای محیط تا دمای K ۵۲۵ پایدار است. در بالاتر از این دما، رفتار ماده دوباره به نوع-p تغییر می کند. بنابراین، جایگزن کردن یون +Cu در شبکه بلوری بورنیت با دو یون ظرفیت بالاتر ۲۵²⁺ و Co²⁺ مکانیزم رسانایی حاکم را از نوع ذاتی به نوع خارجی ضعیف نوع-n با هدایت الکتریکی متوسط تغییر میدهد. در واقع، جایگزین کردن هم زمان دو يون +Zn² و Co²⁺ باعث افزودن الكترون به نوار ظرفيت بورنیت و بالا بردن سطح انرژی فرمی و تغییر رفتار ماده نیمههادی به نوع-n می شود. با این وجود، در دماهای بالاتر از ۵۲۵K، تعداد حامل هایی که توسط حرارت در طول نوار شکاف فعال می شوند، بر تعداد حامل هایی که توسط ناخالصی ها (+Zn² و Co²⁺) فعال میشوند غلبه کرده و هدایت ذاتی نوع-p دوباره غالب میشود. اين پديده مي تواند به دليل موبيليته بيشتر حفرهها نسبت به الكترون در این ماده باشد. تغییر در نوع هدایت در اثر دوپ کردن برای مواد دیگری از جمله Cu₂O دوپ شده با ایندیوم [۲۵] و InN دوب شده با منیزیم [۲۶] نیز گزارش شده است. مقادیر ضریب سیبک برای نمونه Cu_{5-2x}ZnxCo_xFeS₄ در دمای محیط بسیار بزرگ بود، اما مقاومت الكتريكي نمونه ها نيز بسيار بالا بود (حدود ۲۰ mΩm در دمای ۲۰ ۳۵۰) که منجر به مقادیر ضریب توان کم شد (بیشترین PF برابر با ۲۰^{-۱} ۳Wm ۰۱/۰ در دمای ۴۲۵K بود).

(Co₃S₄) در نتایج XRD (شکل ۲-ب) مشاهده شد. در حالی که هیچ نتایجی در رابطه با خواص انتقالی فاز Co₃S₄ وجود ندارد، لذا این تغییر هدایت از نوع-n به نوع-q به رسوب گذاری این فاز ارتباط داده می شود. بیشترین مقدار ضریب سیبک نوع-q برای این نمونه بدست آمد. بنابراین، یک محدوده کاری $x \ge 2$ 0.02 این نمونه بدست آمد. بنابراین، یک محدوده کاری $x \ge 2$ 0.04 این نمونه بدست آمد. بنابراین، یک محدوده کاری $x \ge 2$ 0.04 این نمونه بدست آمد. بنابراین، یک محدوده کاری $x \ge 2$ 0.04 قابل دستیابی است.



۲-۳-۳- هدایت حرارتی دوب کردن نه تنها خواص انتقالی مواد ترموالکتریک را تحت تاثیر قرار میدهد، بلکه به عنوان منبعی از عیوب نقطهای عمل

می کند و در براکنده کردن فنون ها سهیم است [۲۷]. از طرف دیگر، ویژگیهای ریزساختاری در مقیاس نانو میتواند جهت کاهش هدایت حرارتی در اثر تفرق فنونها در مرزدانهها، فازهای ثانویه و غیره مورد استفاده قرار گیرد. یارامترهای دیگری مانند درجه بی نظمی و پیچیدگی ساختار کریستالی نیز نقش اساسی در کاهش هدایت حرارتی دارد [۹]. در مورد بورنیت، توزیع کاملا نامنظم کاتیون های Cu / Fe و تهی جای ها در فاز مکعبی بالا، یا سلول واحد پیچیده و بزرگ بورنیت پایین که شامل ۱۶ اتم آهن، ۸۰ اتم مس، ۳۲ تھی جای و ۶۴ اتم گوگر د است، عامل غالب در تخریب انتقال فنونها و کاهش هدایت حرارتی شبکه است. از طرفي، افزايش مقاومت الكتريكي نيز منجر به كاهش هدايت حرارتي الكتروني نمونه مي شود. هدايت حرارتي الكتروني، هدایت حرارتی شبکه و هدایت حرارتی کل نمونهها به عنوان تابعی از دما در شکل (۸) نشان داده شده است. تمام نمونهها هدایت حرارتی بسیار پایینی دارند. به علاوه، هدایت حرارتی نمونه های دوب شده با کبالت و روی در تمام رنج دمایی کمتر از بورنیت دوپ نشده است. هدایت حرارتی نمونه ها در دمای محیط از W/mK ۰/۴۶ W/mK برای بورنیت دوپ نشده تا حدود ۷/۳K ۸/۰ برای نمونه های دوپ شده کاهش یافت. این کاهش هدایت الکتریکی می تواند به دلیل نوسانات کرنشی و جرمی ناشی از دوپ کردن هم زمان دو عنصر کبالت و روی باشد. ملاحظه میشود هدایت حرارتی الکترونی نمونههای دوپ شده بسیار كمتر از نمونه بورنيت خالص است. اين به دليل افزايش مقاومت الکتریکی نمونه های دوپ شده است (همان طور که در شکل های (۷ و ۸) مشاهده می شود). هدایت حرارتی شبکه نمونه های دوپ شده اندکی کاهش می یابد. می توان نتیجه گرفت که کاهش هدايت حرارتي بورنيت در اثر دوپ كردن، بيشتر ناشي از كاهش هدايت حرارتي الكتروني است تا كاهش هدايت حرارتي شبكه. قبلا گزارش شده بود که طبیعت نامنظم و سلول واحد پیجیده بورنيت عامل اصلي كم بودن هدايت حرارتي اين ماده است، در اينجا نيز ديديم كه دوپ كردن مي تواند هدايت حرارتي را تا حد بیشتری کاهش دهد.



شکل (۸): (الف): هدایت حرارتی الکترونی، (ب): هدایت حرارتی شبکه و (ج): هدایت حرارتی کل، نمونههای Cu_{5-2x}Zn_xCo_xFeS4 به عنوان تابعی از دما

(ZT) -۳-۳- بازده ترموالکتریک (ZT)

بازده ترموالکتریک ZT به عنوان تابعی از دما در شکل ۹ نشان داده شده است. یک ZT حدود ۲/۳ برای نمونه دوپ نشده بدست آمد. به دلیل رفتار الکترونیکی متفاوت نمونه و مقادیر PF مختلف، نمونه های دوپ شده رفتار متفاوتی از خود نشان دادند. دوپ کردن در محدوده $0.04 \ge x \ge 0.00$ باعث کاهش شدید ZT شده است. این کاهش در ZT به دلیل تغییر نوع رسانایی نمونه ها از نوع-n به نوع-p در حین اندازه گیری و مقادیر بسیار کوچک PF بوده است. چون این انتقال با کاهش مقدار ضریب سیبک از مقادیر منفی به مثبت همراه است (و لذا صفر شدن ضریب سیبک

در یک رنج دمایی) مقدار ZT تا حد بسیار زیادی کاهش مییابد [ZT=(PF/XT)T]. برای نمونه دوپ شده با x=0.06مقدار ZT تا ۱۰/۳۵ افزایش یافته است.



۴-نتیجه گیری

با استفاده از روش آلیاژسازی مکانیکی، نانوذرات بورنیت دوپ شده با کبالت و روی ($Cu_{5-2x}Zn_xCo_xFeS_4$ و 0.06 $\ge x \ge 0.00$) سنتز شد و سپس توسط پرس داغ به نمونههای دیسکی شکل نانوساختار تبدیل شد. نتایج XRD نشان داد روی و کبالت می توانند به طور هم زمان تا حد 20.4 بر ساختار نمونههای می توانند به طور هم زمان تا حد 20.4 بر ساختار نمونههای نمونهها دو رفتار متفاوت نشان داد. در محدوده دوپ کردن xooto $\ge x \ge 0.06$ ماده رسانایی نوع – n نشان داد و برای 0.06 = xدوباره رسانایی نوع – q حاکم شد. هدایت حرارتی نمونههای دوپ شده نسبت به نمونه دوپ نشده تا حد بسیار زیادی کاهش یافت شده نسبت به نمونه دوپ نشده تا حد بسیار زیادی کاهش یافت عنصر کبالت و روی برای مس بود. بیشترین مقدار TT برابر با عنصر کبالت و روی شده با 0.06 = x thermoelectricity in earth-abundant compounds based on natural mineral tetrahedrites", Advanced Energy Materials, Vol. 3, pp. 342–348, 2013.

- [10] X. Lu, "Thermoelectric properties of natural mineral based tetrahedrite compounds", In Department of Physics & Astronomy, Michigan State University: ProQuest LLC. pp. 158, 2014.
- [11] P. Qiu, "Sulfide bornite thermoelectric material: a natural mineral with ultralow thermal conductivity", Energy & Environmental Science, Vol. 7, pp. 4000-4006, 2014.
- [12] Y. He, T. Day & T. Zhang, "High Thermoelectric Performance in Non- Toxic Earth- Abundant Copper Sulfide", Advanced Materials, Vol. 26, pp. 3974-3978, 2014.
- [13] B. A. Grguric & A. Putnis, "Compositional controls on phase-transition temperatures in bornite; a differential scanning calorimetry study", The Canadian Mineralogist, Vol. 36, pp. 215-227, 1998.
- [14] G. Guélou, A. V. Powell & P. Vaqueiro, "Ball milling as an effective route for the preparation of doped bornite: synthesis, stability and thermoelectric properties", Journal of Physical Chemistry C, Vol. 3, pp. 10624-10629, 2015.
- [15] V. Pavan Kumar, T. Barbier, P. Lemoine, B. Raveau, V. Nassif & E. Guilmeau, "Crucial role of selenium for sulphur substitution in the structural transitions and thermoelectric properties of cCu5FeS4 bornite", Dalton Transactions, Vol. 46, pp. 2174-2183, 2017.
- [16] A. Ostovari Moghaddama, A. Shokuhfar & A. Cabot, "Thermoelectric properties of nanostructured bornite Cu5-xCoxFeS4 synthesized by high energy ball milling", Journal of Alloys and Compounds, Vol. 750, pp. 1–7, 2018.
- [17] N. Morimoto & G. Kullerud, "Polymorphism in bornite", American Mineralogist, Vol. 46, pp. 1270-1282, 1961.
- [18] B. A. Grguric, A. Putnis & R. J. Harrison, "An investigation of the phase transitions in bornite (Cu5FeS4) using neutron diffraction and differential scanning calorimetry", American Mineralogist, Vol. 83, pp. 1231–1239, 1998.

[1] R. Ahmed, N. S Masuri, B. U. Haq, A. Shaari, S. A. Faifi, F. K. Butt, M. N. Muhamad, M. Ahmed & S. A. Tahir, "Investigations of electronic and thermoelectric properties of half-Heusler alloys XMgN (X = Li, Na, K) by first-principles

[2] A. Zolriasatein, X. Yan, E. Bauer, P. Rogl, A. Shokuhfar & S. Paschen, "Influence of PCA on thermoelectric properties and hardness of nanostructured Ba–Cu–Si clathrates", Materials and Design, Vol. 87, pp. 883-890, 2015.

196-203, 2017.

calculations", Materials and Design, Vol. 136, pp.

- [3] S. Ortega, M. Ibáñez, Y. Liu, Y. Zhang, M. V. Kovalenko, D. Cadavid & A. Cabot, "Bottom-up engineering of thermoelectric nanomaterials and devices from solution-processed nanoparticle building blocks", Chemical Society Reviews, Vol. 46, pp. 3510-3528, 2017.
- [4] H. Wang, J. F. Li, M. Zou & T. Sui, "Synthesis and transport property of AgSbTe2 as a promising thermoelectric compound", Applied Physics Letters, Vol. 93, pp. 202106, 2008.
- [5] R. Chetty, A. Bali & R. C. Mallik, "Tetrahedrites as thermoelectric materials: an overview", Journal of Materials Chemistry C, Vol. 3 pp. 12364-12378, 2015.
- [6] G. J. Snyder & E. S. Toberer, "Complex thermoelectric materials", Nature Materials, Vol. 7, pp. 105-114, 2008.
- [7] D. James, X. Lu, A. C. Nguyen, D. Morelli & S. L. "Brock, design of lead telluride based thermoelectric materials through incorporation of lead sulfide inclusions or ligand stripping of nanosized building blocks", Journal of Physical Chemistry C, Vol. 119, pp. 4635–4644, 2015.
- [8] Y. Zhang, X. Jia, H. Sun, B. Sun, B. Liu, H. Liu, L. Kong & H. Ma, "Suppressing adverse intrinsic conduction of Bi2Te3 thermoelectric bulks by Sb and Cu co-substitutions via HPHT synthesis", RSC Advances, Vol. 6, pp. 7378-7383, 2016.
- [9] X. Lu, D.T. Morelli, Y. Xia, F. Zhou, V. Ozolins, H. Chi, X. Zhou & C. Uher, "High performance

MgAgSb", Acta Materialia, Vol. 128, pp. 227-234, 2017.

- [۲۸] ص. عباسی، س. م. زبرجد، ح. نوعی باغبان و ع. یوسفی، "تاثیر میزان نانوذرات بر روی پایداری و هدایت حرارتی نانوسیال حاوی نانولولههای کربنی آرایش یافته با نانوذرات TiO2"، فرآیندهای نوین در مهندسی مواد، سال ۸، شماره ۲، صفحه ۱-۸/ ۱۳۹۳.
- [۲۹] ص. عباسی و ف. نوری وطن، "سنتز و مشخصه یابی نانومیله های نقره و مس و بررسی هدایت حرارتی نانوسیال حاوی نانومیله های سنتز شده"، فر آیندهای نوین در مهندسی مواد، سال ۱۰، شماره ۴، صفحه ۱۰۱–۱۰۸، ۱۳۹۵.



- [1] figure of merit
- [2] Seebeck coefficient
- [3] Power factor
- [4] Pisarenko

- [19] Y. Ding, D. R. Veblen & C. T. Prewitt, "Highresolution transmission electron microscopy (HRTEM) study of the 4a and 6a superstructure of bornite Cu5FeS4", American Mineralogist, Vol. 90, pp. 1256–1264, 2005.
- [20] Y. Kanazawa, K. Koto & N. Morimoto, "Bornite (Cu5FeS4): stability and crystal structure of the intermediate form", The Canadian Mineralogist, Vol. 16, pp. 397-404, 1978.
- [21] K. Koto & N. Morimoto, "Superstructure investigation of bornite, Cu5FeS4, by the modified partial patterson function", Acta Crystallographica, Vol. 31, pp. 2268-2273, 1975.
- [22] R. Chetty, A. Bali, M. H. Naik, G. Rogl, P. Rogl, M. Jain, S. Suwas & R. C. Mallik, "Thermoelectric properties of Co substituted synthetic tetrahedrite", Acta Materialia, Vol. 100, pp. 266–274, 2015.
- [23] A. Zhang, X. Shen, Z. Zhang, X. Lu, W. Yao, J. Dai, D. Xie, L. Guo, G. Wang & X. Zhou, "Large-scale colloidal synthesis of Cu5FeS4 compounds and their application in thermoelectrics", Journal of Materials Chemistry C, Vol. 5, pp. 301-308, 2017.
- [24] A. Ostovari Moghaddama, A. Shokuhfar, A. Cabot & A. Zolriasatein, "Synthesis of bornite Cu5FeS4 nanoparticles via high energy ball milling: Photocatalytic and thermoelectric properties", Powder Technology, Vol. 333, pp. 160-166, 2018.
- [25] X. Cai, X. Q. Su, F. Ye, H. Wang, X. Q. Tian, D. P. Zhang, P. Fan, J. T. Luo, Z. H. Zheng, G. X. Liang & V. A. L. Roy, "The n-type conduction of indiumdoped Cu2O thin films fabricated by direct current magnetron co-sputtering", Citation: Applied Physics Letters, Vol. 107, pp. 083901, 2015.
- [26] L. Guo1, X. Q. Wang, X. T. Zheng, X. L. Yang, F. J. Xu, N. Tang, L. W. Lu, W. K. Ge, B. Shen, L. H. Dmowski & T. Suski, "Revealing of the transition from n- to p-type conduction of InN:Mg by photoconductivity effect measurement", Scientific Reports, Vol. 4, pp. 4371, 2014.
- [27]Z. Liu, Y. Zhang, J. Mao, W. Gao, Y. Wang, J. Shuai, W. Cai, J. Sui & Z. Ren, "The microscopic origin of low thermal conductivity for enhanced thermoelectric performance of Yb doped

Synthesis of nanostructured bornite by mechanical alloying and investigate the effect of co-doping Zn and Co on its thermoelectric properties

Ahmad Ostovari Moghaddam^{1,*}, Ali Shokuhfar²

1- PhD Student, Faculty of Materials Science and Engineering, Khaje Nasir University of Technology, Tehran, Iran

2- Professor, Faculty of Materials Science and Engineering, Khaje Nasir University of Technology, Tehran, Iran

*Corresponding Author: aostovari@mail.kntu.ac.ir

Abstract

To improve current solid state thermoelectric devices, high performance materials based on safe and abundant elements is required. Here, the thermoelectric properties of Cu_{5-2x}Zn_xCo_xFeS₄ ($0 \le x \le 0.06$) nanostructured samples were investigated. First, Cu_{5-2x}Zn_xCo_xFeS₄ nanoparticles were synthesized by high energy ball milling and then consolidated into pellets by hot pressing. X-ray diffraction (XRD) analysis was employed for structural study, scanning electron microscopy (SEM) and transmission electron microscopy (TEM) were used for microstructural analysis, and the thermoelectric properties were evaluated by electrical conductivity and thermal conductivity measurements. XRD data revealed that the crystal structure of the materials to be consistent with a pure bornite phase up to x = 0.04 for Cu_{5-2x}Zn_xCo_xFeS₄. The power factor of un-substituted sample was 0.25 mWm⁻¹K⁻² which decrease after Co and Zn substitution. Concurrent substituting of Co and Zn for Cu in the range of $0.02 \le x \le 0.04$ changed the p-type conduction of bornite to n-type at room temperature and up to 527 K. Extremely low thermal conductivities of k < 0.30 Wm⁻¹K⁻¹ were obtained for all double substituted samples as a results of the significant mass and strain field fluctuations and the nanostructured nature of the samples. The highest ZT value of 0.35 was attained for x = 0.06.

Keywords: Bornite, Nanostructure, Doping, Mechanical Alloying, Thermoelectric Properties.

Journal homepage: ma.iaumajlesi.ac.ir

Please cite this article using:

Ahmad Ostovari Moghaddam, Ali Shokuhfar, Synthesis of nanostructured bornite by mechanical alloying and investigate the effect of co-doping Zn and Co on its thermoelectric properties, New Process in Material Engineering, 2019, 13(4), 83-94.